

Краткие сообщения по физике № 12 1983

УСКОРЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В УСЛОВИЯХ ДВУХПЛАЗМОННОГО  
РАСПАДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ОКРЕСТНОСТИ РЕ-  
ЗОНАНСА  $n_e/4$

Д. М. Карандов, Н. А. Лукина, К. Ф. Сергеичев

УДК 533.951

Исследовано ускорение электронов в плазме с концентрацией, равной  $1/4$  критической. Механизм ускорения связывается с распадом волны накачки на две лентмировские и модуляционной неустойчивостью лентмировских волн.

Наиболее интенсивная диссипация энергии высокочастотного поля большой амплитуды в плазме, рождающая потоки ускоренных электронов, связана с критической концентрацией  $n_c = \pi\omega^2/4je^2$ , которая отвечает резонансу поля накачки и плазменной частоты  $\omega = \omega_{pe}/11$ . Ускорение электронов является следствием плазменной турбулентности при распаде электромагнитной волны накачки на лентмировскую и звуковую волны. Заметную, хотя и менее интенсивную, диссипацию энергии высокочастотного поля можно ожидать при резонансе обертона накачки и плазменной частоты  $\omega = 2\omega_{pe}$  в области концентрации  $n \approx n_c/4$ , где плазменная турбулентность обуславливается распадом электромагнитной волны накачки на две лентмировские волны /2,3/.

В данной работе в условиях двухплазменного распада в окрестности  $n = n_c/4$  исследованы пороги возникновения потоков ускоренных электронов и их энергетические спектры.

Эксперименты проводились на установке, ранее описанной в [4]. Плазма создавалась сторонним источником с импульсным плазменно-пучковым разрядом вдоль статического поля  $E_0 \leq 100$  Гс в аргоне и гелии при давлениях  $p \sim 10^{-2} - 10^{-3}$  торр. Воздействие СВЧ поля на плазму осуществлялось в стадии ее диффузационного распада, когда распределение концентрации плазмы в пространстве становилось достаточно однородным: характерные размеры неоднородности по оси столба  $\sim 1$  м и по радиусу  $\sim 0,3$  м. Параметры плазмы измерялись калиброванным ленгмюровским зондом. Концентрация плазмы в центре столба составляла  $n_0 \approx n_c/4 \approx 10^{11}$  см<sup>-3</sup>, а температура электронов  $T_e$  варьировалась в пределах 0,3-1 эВ.

СВЧ излучение, создаваемое импульсным генератором (длина волны  $\lambda = 5$  см, длительность импульса  $\sim 10^{-5}$  с, мощность  $\leq 10^5$  Вт), с помощью рупорно-линзовой антенны формировалось в пучок с характерным диаметром  $\sim 3\lambda$ . Оптическая ось пучка ориентировалась перпендикулярно оси столба плазмы так, чтобы вектор

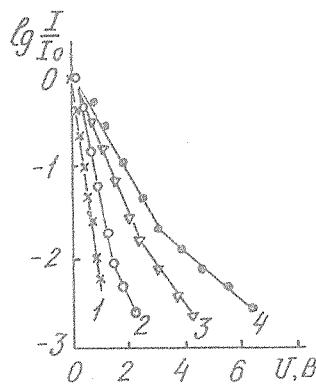


Рис. 1. Электронная ветвь характеристики ленгмюровского зонда, расположенного в центре области взаимодействия пучка СВЧ излучения с плазмой: 1 -  $E_0 = 0$ ; 2 -  $E_0 = 220$  В/см; 3 -  $E_0 = 400$  В/см; 4 -  $E_0 = 600$  В/см

напряженности электрического поля волны  $E_0$  был коллинеарным с осью столба (направлением наибольшей однородности плазмы).

Под действием СВЧ излучения достаточно высокой интенсивности ( $E_0 \geq 100$  В/см) на оси плазменного столба были зарегистрированы "хвосты" ускоренных электронов. Из семейства электронных ветвей зондовых характеристик, полученных при различных напряженностях поля накачки (рис. 1), видно, что с увеличением  $E_0$  параллельно с нагревом основной массы электронов (уменьшение производной  $d(1/g\lambda)/dU$  левой части зондовых характеристик до перегиба) увеличивается ток и энергия электронов в хвосте функции распределения, причем, как видно из рис. 1, средняя энергия электронов в хвостах (после перегиба) может быть охарактеризована эффективной температурой  $T_h$ . Рост тока  $I_h$  и температуры  $T_h$  ускоренных электронов в зависимости от поля накачки  $E_0$  представлены на рис. 2. Обе зависимости, особенно  $I_h (E_0)$ , указывают на существование порога генерации потока ускоренных электронов, в данном случае  $E_{0(th)} \approx 100$  В/см. Оказалось, что пороговая напряженность поля  $E_{0(th)}$  не зависит от начальной температуры электронов  $T_0$ , от рода газа (массы ионов), но зависит от частоты столкновений электронов  $\nu_e$ . Набор данных о пороговой напряженности поля представлен на рис. 3 в виде зависимости безразмерного параметра  $v_{E(th)}/c$ , характеризующего отношение скорости осциляции электрона в пороговом поле  $v_{E(th)} = eE_{0(th)}/m\omega_0$  к скорости света  $c$ , от другого безразмерного параметра  $4\nu_e/\sqrt{3}\omega_0$ , характери-

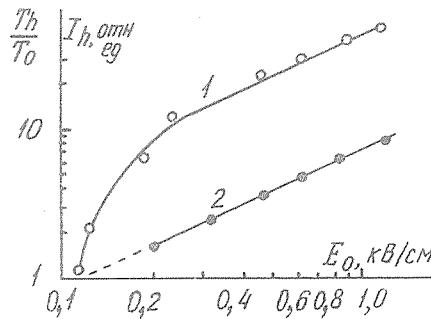


Рис. 2. Зависимость тока (1) и эффективной "температуры" (2) ускоренных электронов от напряженности поля накачки

зующего столкновительную диссипацию и, согласно /2/, дающего теоретическое значение порога двухплазменного распада с достаточно малыми значениями волновых векторов  $k$ :  $k_{De}^r < k_{st}^r \approx 0,2$  ( $k_{st}$  – волновой вектор, для которого вклады столкновительного затухания и бесстолкновительного затухания ленгмировской волны сравниваются). Соответствие экспериментальных данных о порогах с теоретической зависимостью, представленной на рис. 3 прямой линией (под углом  $45^\circ$ ), доказывает связь эффекта ускорения электронов при концентрации плазмы  $n_e/4$  с двухплазменным распадом.

Из отношения плотности тока ускоренных электронов к плотности теплового тока, которое при небольшом превышении порогового поля достигает величины  $I_E/I_0 \sim 3 \cdot 10^{-2}$  (рис. 2), нетрудно оценить долю ускоренных электронов, которая составляет  $< 1\%$ . Столь эффективное вовлечение электронов плазмы в ускорение ленгмировской волной с  $k_{De}^r < 0,2$  трудно объяснить базовым синхронизмом и захватом электронов в потенциальное поле волны.

Можно предположить, что ускорение электронов обязано возникновению модуляционной неустойчивости длинноволновых плазменных колебаний /3/, при которой, вследствие перекачки ленгмировской энергии коллипсирующим кавернами в коротковолновую часть спектра, уже становится возможным поглощение колебаний резонансными электронами.

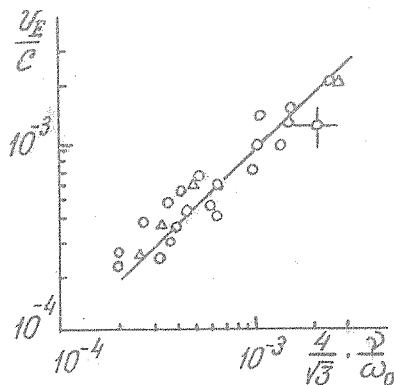


Рис. 3. Пороги генерации ускоренных электронов

Исходя из предположения  $v_n v_b T_b \leq (E_1^2 / 8\pi) v_g kx_{De}$ , т.е., что плотность потока энергии ускоренных электронов соответствует нижнему пределу плотности потока энергии ленгмировских волн, для  $kx_{De} = 0,2$  получаем минимальную оценку электрической напряженности ленгмировского поля, которое соответствует значению параметра  $E_1 \min / 4\pi kT_0 \sim 0,1$ . Полученная оценка  $E_1 \min$  превосходит пороговую напряженность для возникновения модуляционной неустойчивости /3/:

$$E_1^2 / 4\pi kT_0 = 9kx_{De} (m/M)^{1/2} \approx 7 \cdot 10^{-3} (\text{Ар}), \quad 2 \cdot 10^{-2} (\text{Не}).$$

Эффективная частота столкновений  $\gamma_{eff}$ , характеризующая диссиацию энергии высокочастотного поля накачки в турбулентном плазменном поле при двухплазменном распаде /5,6/  $\gamma_{eff}/\omega_{pe} \sim T_0/mc^2$ , в холодной плазме с  $T_0 \sim 1$  эВ оказывается невысокой:  $\gamma_{eff} \sim 10^{-6} \omega_{pe} \sim 4 \cdot 10^4 \text{ е}^{-1}$ . В горячей лазерной плазме эффективность поглощения энергии оказывается на 3 порядка выше. Оценка  $\gamma_{eff}$  по потоку ускоренных электронов совпадает по порядку величины с оценкой по приведенной формуле.

Авторы благодарят Г. М. Батанова за обсуждение работы.

Поступила в редакцию  
31 мая 1983 г.

#### Л и т е р а т у р а

1. А. А. Галеев и др., ЖЭТФ, 73, 1353 (1977).
2. С. С. Liu, M. N. Rosenbluth, Phys. Fluids, 19, 967 (1976).
3. Р. З. Сагдеев и др., ЖЭТФ, 82, 125 (1982).
4. Д. М. Карбышов, Н. А. Лукина, К. Ф. Сергеичев, Физика плазмы, 7, 136 (1981).
5. А. М. Рубенчик, ЖЭТФ, 68, 1005 (1975).
6. В. Ю. Быченков, В. П. Силин, В. Т. Тикончук, Письма в ЖЭТФ, 26, 309 (1977).